

	<h2 style="color: red;">FDI045N10A-F102</h2>
 <p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	Hersteller-Teilenummer: FDI045N10A-F102
	Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor
	Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 100V 120A I2PAK-3
	Datenblätter:  FDI045N10A-F102.pdf
	RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand: New original, 238 pcs Stock Available.
Liefern von: Hong Kong	
Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	






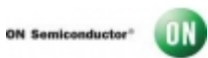


Spezifikationen

Teilenummer	FDI045N10A-F102
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 100V 120A I2PAK-3
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	238 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	I2PAK (TO-262)
Serie	PowerTrench®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	4.5 mOhm @ 100A, 10V
Verlustleistung (max)	263W (Tc)
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	TO-262-3 Long Leads, I ² Pak, TO-262AA
Andere Namen	FDI045N10A_F102
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	5270pF @ 50V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	74nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	100V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 100V 120A (Tc) 263W (Tc) Through Hole
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	120A (Tc)

FDI045N10A-F102 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FDI045N10A-F102-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FDI045N10A-F102 AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ FDI045N10A-F102 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>FDI040N06 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 120A I2PAK</p>	 <p>FDI038AN06AO FAIRCHILD FDI038AN06AO FAIRCHILD</p>	 <p>FDI045N10A_F102 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 120A I2PAK-3</p>	 <p>FDI10-250Q 3M FM DISCONNECT FULLY NYLON INS</p>
 <p>FDI047AN08AO Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 75V 80A TO-262AB</p>	 <p>FDI045N10A AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 120A I2PAK-3</p>	 <p>FDI045N10A Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 120A I2PAK-3</p>	 <p>FDI047AN08AO FAIRCHILD FDI047AN08AO FAIRCHILD</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

FDI045N10A-F102 AMI Semiconductor	FDI045N10A-F102 Datenblatt	FDI045N10A-F102-Datenblätter	FDI045N10A-F102 PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
FDI045N10A-F102 Electronic	FDI045N10A-F102-Komponenten	FDI045N10A-F102-Verteiler	FDI045N10A-F102-Bild	FDI045N10A-F102-Teil
FDI045N10A-F102 Preis	FDI045N10A-F102 Hersteller	FDI045N10A-F102 Bild	FDI045N10A-F102 Aktie	FDI045N10A-F102 Inventar
FDI045N10A-F102 Neu	FDI045N10A-F102 Original	FDI045N10A-F102 garantiert	FDI045N10A-F102 RFQ	FDI045N10A-F102 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited